(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年10月2日(02.10.2025)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2025/205963 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/304 (2006.01) *C09J 201/00* (2006.01)
B32B 7/12 (2006.01) *H01L 21/02* (2006.01)

(21) 国際出願番号： PCT/JP2025/012057

(22) 国際出願日： 2025年3月26日(26.03.2025)

(25) 国際出願の言語： 日本語

(26) 国際公開の言語： 日本語

(30) 優先権データ：
特願 2024-051117 2024年3月27日(27.03.2024) JP

(71) 出願人：日産化学株式会社(**NISSAN CHEMICAL CORPORATION**) [JP/JP]；〒1036119 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 (JP).

(72) 発明者：臼井 友輝(**USUI Yuki**)；〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉６３５ 日産化学株式会社材料科学研究所内 (JP). 奥野 貴久(**OKUNO Takahisa**)；〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉６３５ 日産化学株式会社材料科学研究所内 (JP). 岸岡 高広(**KISHIOKA Takahiro**)；〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉６３５ 日産化学株式会社材料科学研究所内 (JP).

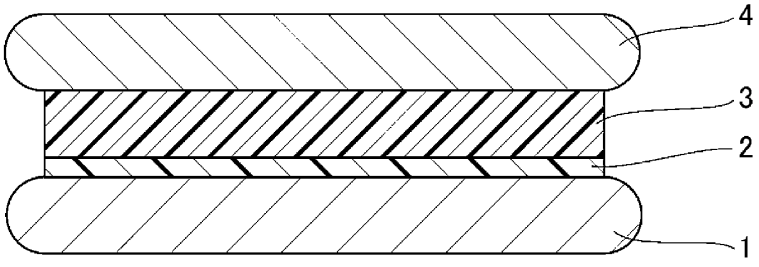
(74) 代理人：高岡 亮一，外 (**TAKAOKA Ryoichi** et al.)；〒1710021 東京都豊島区西池袋５－４－７ 池袋トーセイビル５階 高岡ＩＰ特許事務所 (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能)：AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能)：ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(54) **Title:** LAMINATE AND METHOD FOR FABRICATING PROCESSED SEMICONDUCTOR SUBSTRATE

(54) 発明の名称： 積層体、及び加工された半導体基板の製造方法



(57) **Abstract:** The present invention provides a laminate comprising: a first base body, which is a semiconductor substrate or an electronic device layer; a second base body, which is a support substrate that allows infrared laser light to be transmitted therethrough; and an infrared-transmissive adhesive layer and an infrared-absorbing layer provided between the first and second base bodies.

(57) 要約：半導体基板又は電子デバイス層である第１基体と、赤外線レーザーを透過する支持基板である第２基体と、前記第１基体と前記第２基体との間に設けられた、赤外線透過性接着剤層と赤外線吸収層とを有する積層体。

［続葉有］

WO 2025/205963 A1

添付公開書類：

一　国際調査報告（条約第21条(3)）